#### 研究成果報告書 科学研究費助成事業

今和 4 年 6 月 1 7 日現在

機関番号: 82401

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2019~2021

課題番号: 19K05258

研究課題名(和文)軌道ラシュバ効果や軌道モメント輸送によるスピン操作に関する研究

研究課題名(英文)Research on spin manipulation by orbital Rashba effect and orbital moment transport

#### 研究代表者

金 俊延 (Kim, Junyeon)

国立研究開発法人理化学研究所・創発物性科学研究センター・研究員

研究者番号:50753646

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3.300.000円

研究成果の概要(和文):より効率の高いスピントロニクスの実現を目指して、最近注目されている軌道モーメントによるスピン制御に関して実験研究を行い、不明であったこれの物性の解明が達成された。特に「強磁性体/非磁性金属/酸化物」三層膜構造に焦点を当てて研究を行い、「軌道モーメント生成や伝播」や「伝播された軌道モーメントの強磁性体における作用」の観点で課題を分けてスピン制御の効率性を決める要素を明らかにし た。またスピン制御の効率性変調の基になる現象を見出すことまで進んだ。

研究成果の学術的意義や社会的意義電子が持っているさまざまな特性において、活用する範囲を広げることにより革新的なエレクトロニクスの展開が開いてきた。今まで電子輸送に関する基礎物性物理・デバイス応用分野の両領域において深く工夫されたことのない電子の特性である軌道モーメントについて、本研究ではその基礎物性を明らかにすることで、革新的なエレクトロニクスに至る道を設ける意義を持っている。特にスピンを用いるスピントロニクス分野において軌道モーメントの利用は効率性の向上と機能性の拡張を同時にもたらす。

研究成果の概要(英文): To realize more efficient spintronic device, we experimentally studied spin manipulation induced by orbital moment. and succeeded to clarify veiled physical properties. Here we focused to ferromagnet/non-magnet metal/oxide trilayer. We successfully extracted critical determining factors for the efficiency of the spin manipulation after dividing subjects to <generation and transport of the orbital moment>, and <action on the ferromagnet by the orbital</pre> moment>. Also we found a mechanism for the modulation of the spin manipulation from this study.

研究分野: スピン物性

キーワード: オービットロニクス スピントロニクス 軌道モーメント スピン 輸送特性 スピン制御 界面 磁 性

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

### 1.研究開始当初の背景

(1) ある物質系において電荷電流の注入により同一な向きで整列されたスピンの発生が誘起される現象を指す「スピン変換」は効率的なスピン制御の手法と見なされ、近年集中的に研究されてきた。しかしスピン変換はスピン軌道相互作用により起きる現象であるため、その材料は重元素を含めた材料に限られる問題点が指摘されている。

(2)スピン変換と同様に電荷電流の注入により整列された軌道 モーメントの発生が起こり、これを「軌道変換」と呼ぶ(図1)。 軌道変換に関しては 2005 年ごろから理論的な議論が開始され たが、これを直接にスピンの制御に用いることまでは至られな かった。本研究の開始視点になってから非磁性材料からの軌道 モーメントが強磁性体の磁化(スピン)と直接に相互作用する ことによりトルクを誘起し、磁化の向きを変える可能性が理論 的に提示され始まった。また本研究者は先行研究を通して CoFe/Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 三層膜において、Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 界面からの軌道変換 のため非常に効率の高いスピン制御が誘起されることを発見した。



図1.軌道変換

(3)軌道変換はスピン変換とは異なりスピン軌道相互作用による現象ではないため、Cu/Al₂O₃界面のような原子量の小さい軽い材料系においても効率高く変換が起きる。これはより効率や機能性の高いスピントロニクスの創成を向けて軌道モーメントを用いるスピン変換の学理を構築すべき理由になる。しかし、研究開始の時点では軌道変換や軌道モーメントの輸送に関する全般的な理解の不足のため、スピン制御の効率に影響を及ぼす要素・特性などは不明な状態であった。

#### 2.研究の目的

(1)本研究の究極的な目的は軌道モーメントによるスピン制御の学理を構築し、スピン制御の効率性を決める要素・特性を明らかにすることであった。

(2)上記の究極的な目的を達成するため、「強磁性体/非磁性金属/酸化物」三層膜構造に研究範囲を絞って、軌道変換と生成された軌道モーメント輸送の効率性を決める要素、また強磁性膜に伝播された軌道モーメントがトルクを起こす際に影響を及ぼす要素を明らかにすることを具体的な研究目標として設定した。

#### 3.研究の方法

(1) 本研究では電子ビーム蒸着、またはスパッタ手法を用いて「強磁性体/非磁性金属/酸化物」三層膜構造を成膜した。デバイス製作はフォトリソグラフィ手法を用いて行った。

(2)軌道モーメントによるスピン制御効率性の評価は主に外部磁場印加の下に、GHz 領域の電荷電流の注入により誘起されるトルク観測により行われた(図2)。これはトルクにより発生される磁性膜の磁気共鳴を電気的に測定することで行われる。また軌道変換によるトルクが起こす磁気抵抗の測定、ホール効果測定なども補助的な手法として採用した。

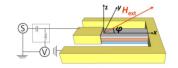


図2.トルク測定の概念図

(3)材料の構造特性と軌道モーメントによるスピン制御効率性の関係を解明するため、共同研究を展開した。電子顕微鏡観測のためには NIMS の研究者、X 線照射による物質評価のためには東京大学の研究者と連携した。

(4)軌道モーメントによりスピン制御の物性の探索は韓国(POSTECH)とドイツ (Peter Grünberg Institut and Institute for Advanced Simulation) の理論研究者との連携で行われた。

(5)サンプルの制作・測定は部分的に中国(Tsinghua Univ.、ShanghaiTech Univ.)との連携で行われた。

# 4. 研究成果

(1)酸化物の種類に依存するスピン制御の効率: 軌道モーメントによるスピン制御の効率性の問題の中、「非磁性金属/酸化物」界面における軌道変換の効率性を決める要素は界面における酸素蓄積の程度であることが分かった。本研究では先行研究の  $CoFe/Cu/Al_2O_3$  三層膜と同様の CoFe/Cu/OX (  $OX = SiO_2$ 、 $TiO_2$ 、MgO ) 三層膜における軌道モーメントによるスピン制御を調

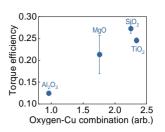


図 3.酸化物に依存するス ピン制御の効率

(2)軌道モーメントの輸送とスピン制御の効率:軌道モーメントが効率よく流れなりやすい材料を求めて、Ru を含めた CoFe/Ru/Al $_2$ O $_3$  三層膜における効率の高いスピン制御を観測した。先行研究で使われた CoFe/Cu/Al $_2$ O $_3$  三層膜の場合、Cu/ Al $_2$ O $_3$  界面で誘起された軌道モーメントが Cu膜を通過して CoFe 膜に伝播される。しかし、Cuの 3 d 軌道構造はたいてい埋めているため、3 d 軌道状態を通じて伝播される軌道モーメントの輸送のために最適な材料ではない問題点がある。この問題に対して Cuの代わりに 3 d 軌道状態において空きの多い材料 (例え、Ru)が軌道モーメントの輸送により適する環境をもたらすと予想される。本研究では CoFe/Ru/Al $_2$ O $_3$  三層膜におけるスピン制御の効率性が CoFe/Cu/Al $_2$ O $_3$  三層膜におけるスピン制御の効率性より 2 倍ほど大きいことを観測した。Ru/Al $_2$ O $_3$  界面と Cu/Al $_2$ O $_3</sub> 界面における軌道変換の効率はまだ不明であるが、少なくても効率の高い軌道モーメントによるスピン制御を求めて Ru は有用な材料であることを示す。この研究内容は Liao <math>et\ al$ ., Phys. Rev. B 105, 104434 (2022) で掲載されている。

(3)強磁性体の種類に依存するスピン制御の効率:FM/Cu/AI<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(FM=Ni、Ni<sub>80</sub>Fe<sub>20</sub>、Fe、Co<sub>25</sub>Fe<sub>75</sub>、Fe)三層膜において軌道モーメントによるスピン制御を強磁性体の種類により系統的に調べ、その効率性が強磁性体の種類により最大 1 0 0 倍以上変わることを発見した(図4)。これは一般的なスピントルクの場合、強磁性体依存性が最大 3 倍前後であったことと対照的である(Zhang et al., Nat. Phys. 11, 496 (2015))。この問題に対して電子顕微鏡観測を行い、効率性の高い FM=Co<sub>20</sub>Fe<sub>80</sub> の場合と比べ FM=Ni の場合は強磁性体と Cu の混成が強く起きたことが分かった。軌道モーメントの輸送の場合、スピン輸送とは異なり混成による界面状態の乱れによりその情報を失いやすくなるため、これに従いスピン制御の効率も強い強磁性体依存性を示す。スこのような軌道モーメントによるスピン制御の特徴的な現象はKim et al., Phys. Rev. B 103, L020407 (2021) に掲載されている。

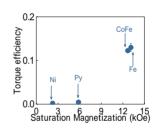


図 4.強磁性体に依存する スピン制御の効率

(4)熱処理に依存するスピン制御の効率: $Co_{25}Fe_{75}/Cu/AI_2O_3$  三層膜において熱処理の温度に依存して軌道モーメントによるスピン制御の効率性が最大 2.5 倍ほど変わることが分かった(図 5 )。これは熱処理によりほぼ変わらないスピントルクの効率性と対照的である(Kim et al. Phys. Rev. Lett. **116**, 097201 (2016) )。項目 3 と同様に電子顕微鏡観測を行い、熱処理により $Co_{20}Fe_{80}/Cu$  界面においてよりきれいに物質の分離が起こることが分かった。そのため、熱処理を行った構造においては軌道モーメントがその情報を失わず  $Co_{25}Fe_{75}/Cu$  界面を通過することになるため、スピン制御の効率性が大きくなる。このような軌道モーメントによるスピン制御の特徴的な現象は Kim et al., Phys. Rev. B **103**, L020407 (2021) に掲載されている。

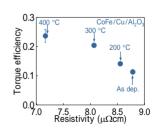
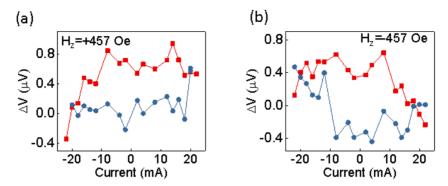


図 5.熱処理の温度に依存 するスピン制御の効率

(5)強磁性膜における酸素蓄積に依存するスピン制御の効率: $Co_25Fe_75/Cu/AI_2O_3$ 三層膜において、Cu 膜の自然酸化により軌道モーメントによるスピン制御の効率が最大 2 倍ほど変わることが分かった。これについて電子顕微鏡観測の結果、Cu 膜の自然酸化時間に依存して Cu 膜内の酸素蓄積量はあまり変わらず、その代わりに Cu 膜の下に位置する  $Co_20Fe_80$  膜に蓄積される酸素の量が大きく変わることが分かった。以上の結果をまとめると、 $Cu/AI_2O_3$  界面から発生されて強磁性膜に伝播された軌道モーメントは強磁性膜においてトルクを誘起する際に、膜内の酸素蓄積により激しく影響を受けていることを示す。このような現象は今後、スピン制御の効率の変調の基盤技術として使われると予想する。以上の結果は現在論文準備中である。

(6)軌道モーメントによる磁化反転:  $Co_{25}Fe_{75}/Cu/AI_2O_3$ 三層膜において直流電荷電流と若干の垂直方向の磁場の印加で  $Co_{25}Fe_{75}$ 膜の磁化反転を達成した(図 6)。以上の結果はは Kim *et al.*, Phys. Rev. B **103**, L020407 (2021) に掲載されている。



**図 6.**軌道モーメントによる磁化判定。 V はプラナーホール効果(Planar Hall effect)の変化量。(a)と(b)は各々 + 457 0e と-457 0e のデバイス垂直方向磁場を印加しづつ行われた。

### 5 . 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計3件(うち査読付論文 3件/うち国際共著 2件/うちオープンアクセス 1件)	
「推協論文」 前3件(プラ直統的論文 3件/プラ国際共者 2件/プラオープングプセス 1件) 1.著者名	4 . 巻
Liao Liyang, Xue Fenghua, Han Lei, Kim Junyeon, Zhang Ruiqi, Li Lun, Liu Jiuming, Kou Xufeng, Song Cheng, Pan Feng, Otani YoshiChika	105
2. 論文標題	5.発行年
Efficient orbital torque in polycrystalline ferromagnetic-metal/Ru/Al203 stacks: Theory and experiment	2022年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Physical Review B	104434-1 ~ 6
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1103/PhysRevB.105.104434	有
オープンアクセス	国際共著 該当する
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	以当りる
1 . 著者名	4.巻
Junyeon Kim, Dongwook Go, Hanshen Tsai, Daegeun Jo, Kouta Kondou, Hyun-Woo Lee, and YoshiChika Otani	103
2 . 論文標題	5.発行年
Nontrivial torque generation by orbital angular momentum injection in ferromagnetic- metal/Cu/Al203 trilayers	2021年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Physical Review B	L020407-1~6
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	   査読の有無
10.1103/PhysRevB.103.L020407	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	該当する
1.著者名	4.巻
Jorge Puebla, Junyeon Kim, Kouta Kondou & Yoshichika Otani	1
2 . 論文標題	5.発行年
Spintronic devices for energy-efficient data storage and energy harvesting	2020年
3 . 雑誌名	6.最初と最後の頁
Communications Materials	1-9
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1038/s43246-020-0022-5	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	-
〔学会発表〕 計4件(うち招待講演 3件/うち国際学会 2件)	
1.発表者名 Junyeon Kim, Dongwook Go, Daegeun Jo, Hyun-Woo Lee, YoshiChika Otani	

Junyeon Kim, Dongwook Go, Daegeun Jo, Hyun-Woo Lee, YoshiChika Otani

# 2 . 発表標題

Determination of orbital torque efficiency in ferromagnet/Cu/Oxide thin films

# 3 . 学会等名

第69回 応用物理学会 春季学術講演会

# 4.発表年

2022年

1	双丰业夕
	<b>平大石石</b>

Junyeon Kim and YoshiChika Otani

# 2 . 発表標題

Non-trivial orbital torque in ferromagnetic metal/Cu/Al203

### 3.学会等名

2021 MRS Fall Meeting (招待講演) (国際学会)

### 4.発表年

2021年

### 1.発表者名

Junyeon Kim, Dongwook Go, Hanshen Tsai, Daegeun Jo, Kouta Kondou, Hyun-Woo Lee, YoshiChika Otani

### 2 . 発表標題

Orbital torque for efficient spin manipulation

#### 3.学会等名

韓国物理学会学術大会(招待講演)

### 4.発表年

2021年

### 1.発表者名

J. Kim, D. Go, H. Tsai, D. Jo, K. Kondou, H. Lee & Y. Otani

### 2 . 発表標題

Orbital torque in ferromagnetic metal/Cu/Al203

### 3.学会等名

New Perspective in Spin Conversion Science (NPSCS2020)(招待講演)(国際学会)

### 4.発表年

2020年

## 〔図書〕 計0件

### 〔出願〕 計1件

産業財産権の名称 スピントルク発生素子、その製造方法、及び、磁化制御装置	発明者 大谷義近、金俊延、 近藤浩太	権利者同左
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、JP2019/042137	2019年	外国

### 〔取得〕 計0件

〔その他〕

6	.研究組織				
	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考		

# 7. 科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

# 8. 本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関			
韓国	Pohang Univ. of Sci. and Tech.			
ドイツ	Forschungszentrum Julich and JARA	Johannes Gutenberg University Mainz		
中国	Tsinghua University	ShanghaiTech University		